

厚硅半导体探测器表面现象的研究

@王征华

收稿日期 修回日期 网络版发布日期:

摘要 本文研究了N-I-P型探测器的表面现象与反向电流的关系。若只考虑表面复合速度,忽略反型层的影响,而在电场作用下表面复合速度对光谱性能的影响的计算结果与实验结果又不符合,则说明表面现象不能只用表面复合速度来解释。此外,用克里斯坦森(H.Christenson)方法观察了反型层与沟道的形成,并对反向电流产生的原因作了定性的解释。

关键词

分类号

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [\[PDF全文\]\(582KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 无 相关文章](#)

▶ [本文作者相关文章](#)

Abstract

Key words

DOI

通讯作者